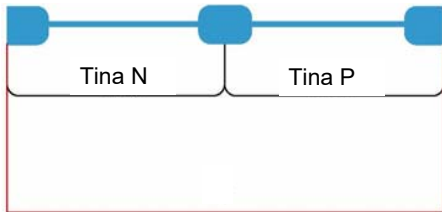


Implantación iónica de tina N  
para transistor PMOS



Difusión de dopantes se activa con  
temperatura para alcanzar  
profundidad de tina requerida